# 

GaAs 单片集成驱动放大器 18~40GHz 20dBm

Rev 1.0

#### 关键指标

▶ 频率范围: 18~40GHz

▶ 增益: 14dB

▶ 输出 P-1dB: 22dBm Typ. 20dBm Min.

➤ 工作电压: +5V/-Vg➤ 输出 IP₃:30dBm@38GHz

▶ 平衡式放大器

▶ 芯片尺寸: 2.3mm×1.25mm×0.1mm

# 产品简介

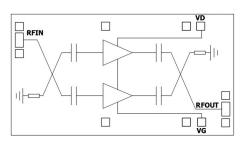
XT3931 放大器工作频率为  $18~40\,GHz$ ,增益为 14dB,输出  $IP_3$ 为 30dBm,输出  $P_1dB$  22dBm,工作电压+5V,电流 250~400mA,该放大器适用本振驱动等用途,在工作和非工作时输入与输出端口均能保持较好的匹配特性。

该芯片表面有钝化层保护,有较好的环境

#### 典型应用

- 本振驱动
- ➤ RF/微波电路
- ▶ 高密度 MCM 组件

#### 功能框图



#### 电性能 (T<sub>A</sub>=25°C,V<sub>D</sub>=+5V,I<sub>D</sub>=350mA,Z<sub>0</sub>=50Ω)

指标	最小值	典型值	最大值	单位	
频率		18~40		GHz	
增益	12	14	22	dB	
增益平坦度	_	_	±3.5*	dB	
反向隔离度	_	-35	_	dB	
输入/输出驻波		1.35	2.0	: 1	
比	_	1.33	2.0	. 1	
噪声系数	_	6	_	dB	
输出 P₋₁dB	20	22	_	dBm	
输出 IP <sub>3</sub>	_	30**	_	dBm	
工作电流	_	350	500	mA	
供电电压	5	_	6	V	
热阻		22		°C/W	

<sup>\*</sup> 正斜率

#### 绝对最大额定值

最大输入功率	+15dBm, CW 1min	工作温度	-55℃~+85℃
沟道温度	150℃	贮存温度	-55℃~+150℃
供电电压	6.5V		

办公地址:成都市高新西区天彩路98号B区4楼

联系电话: 028-87932498/028-87929948 传真: 028-87933348 网址: www.fairchild-tech.com 邮箱: sales@fairchild-tech.com

<sup>\*\*</sup>Pin/Tone=0dBm fc=30GHz,△f=4MHz

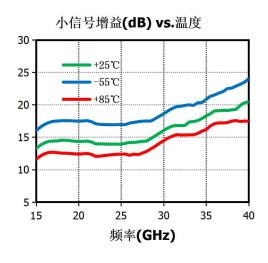


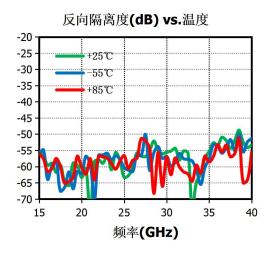
GaAs 单片集成驱动放大器 18~40GHz 20dBm

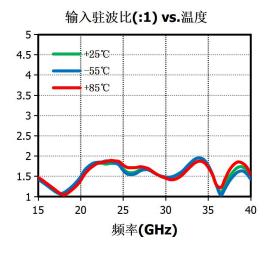
**Rev 1.0** 

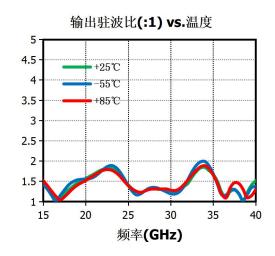
### 典型性能曲线

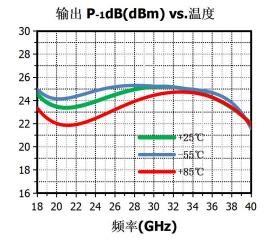
### V<sub>D</sub>=+5V, I<sub>DQ</sub>=350mA, 使用 XT3931 评估板测试得到的结果,未做去嵌入处理

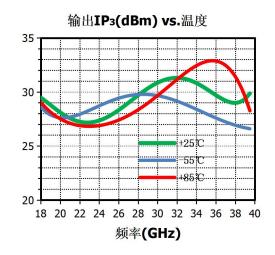












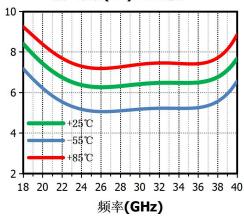
2



GaAs 单片集成驱动放大器 18~40GHz 20dBm

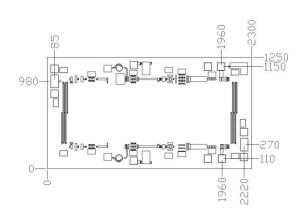
**Rev 1.0** 

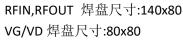


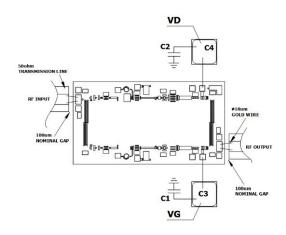


# 外形尺寸图 (μm)

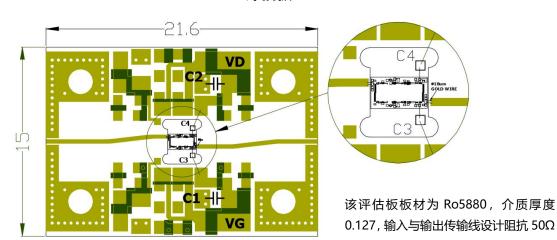
### 推荐装配图







### XT3931 评估板



# 💥 成都仙童科技有限公司

3

# **XT3931**



GaAs 单片集成驱动放大器 18~40GHz 20dBm

Rev 1.0

# 元件清单

编号	数值	型号	制造商	封装
C1、C2	2.2uF	_	ANY	0603
C3、C4	10pF	_	ANY	SLC

#### 注意事项

- 1. 芯片在干燥、氮气环境中存储,在超净环境使用;
- 2. GaAs 材料较脆,不能触碰芯片表面,使用时必须小心;
- 3. 芯片用导电胶或合金烧结(合金温度不能超过300℃,时间不能超过30秒),使之充分接地;
- 4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.1mm, 使用Φ18μm 双金丝键合, 建议金丝长度 150~250μm;
- 5. 芯片对静电敏感,在储存和使用过程中注意防静电;
- 6. 芯片射频输入和输出端口已集成隔直电容。